С. В. ЧЕРНЫХ

ВОЗМОЖНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ НА ОСНОВЕ ГРАНУЛИРОВАННЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ

Представлен прогноз о достижимой чувствительности магнитных датчиков на основе гранулированных сверхпроводников, базирующийся на результатах экспериментальных и теоретических исследований процесса проникновения магнитного поля в высокотемпературный сверхпроводник состава YBa₂Cu₃O_{7-x}.

Ключевые слова: гранулированные сверхпроводники, магнитные датчики, чувствительность.

Введение. Понимание процесса проникновения магнитного поля в гранулированные сверхпроводники (высокотемпературную керамику) крайне важно для создания новых и совершенствования существующих датчиков измерителей слабых магнитных полей. Этот вопрос изучался во многих работах, однако он так и остается до конца не исследованным. Сравнительный анализ известных публикаций показывает, что в этой области существуют вопросы, требующие дополнительных исследований.

Так, в работе [1] утверждается, что глубина проникновения переменного (72 Гц) магнитного поля в образец высокотемпературного сверхпроводника (ВТСП) составляет около 0,5 мм, при этом в исследованиях "использовался миниатюрный датчик Холла с размерами рабочей области 50×50 мкм и толщиной 180 мкм". В работе [2] говорится, что глубина проникновения переменного (100—150 МГц) магнитного поля в образец ВТСП составляет около $2 \cdot 10^{-3}$ мм, ВТСП-материалы, облученные быстрыми нейтронами реактора, исследовались методом высокочастотного поглощения. В этих работах изучались ВТСП состава YBa₂Cu₃O_{7-x}.

Предположим, что глубина проникновения переменного магнитного поля зависит от частоты по какому-либо закону. Однако в работе [1] приводится утверждение о независимости "градиента потока индукции в образцах" от частоты в диапазоне 5—500 Гц. В работе [3] также сообщается о независимости магнитного отклика ВТСП-образца YBa₂Cu₃O_{7-x} от частоты в диапазоне от 60 Гц до 1 МГц и, возможно (на основе теоретических изысканий), до 10 ГГц. Таким образом, глубина проникновения переменного магнитного поля в образец ВТСП на частоте 72 Гц отличается от глубины проникновения на частоте 100—150 МГц в 250 раз, но поток переменного магнитного поля в образец ВТСП на основе YBa₂Cu₃O_{7-x} изготавливаются датчики измерителей слабых магнитных полей. Достигнутая чувствительность таких измерителей составляет $2 \cdot 10^{-7}$ $\Im/\sqrt{\Gamma \mu}$ [4, 5]. В литературе не приводятся оценки возможной предельной чувствительности таких датчиков (именно датчиков, но не самих измерителей). Хотя авторы работы [5] утверждают, что, оптимизируя параметры как самого измерителя, так и его датчика, можно добиться чувствительности измерителя $\sim 10^{-8}$ $\Im/\sqrt{\Gamma \mu}$ и выше, но никакого обоснования заявленной величины они не приводят.

Вопрос о взаимосвязи глубины проникновения переменного магнитного поля в образец ВТСП и чувствительности магнитных датчиков из таких же ВТСП рассматривается в настоящей статье. На основе сравнения результатов экспериментальных и теоретических исследований магнитных свойств ВТСП-керамики формируется модель гранулированного сверхпроводника, используемая для прогнозирования предельно достижимой чувствительности датчиков магнитного поля. Исследования проводились на ВТСП состава YBa₂Cu₃O_{7-х}, изготовленных методом твердофазного синтеза. Методика измерений и результаты эксперимента. Экспериментальная установка (рис. 1) состоит из генератора синусоидального напряжения (Г), управляемого им источника тока (ИТ), датчика (Д) и селективного вольтметра (В). Датчик представляет собой две обмотки (токовую и

сигнальную), одна поверх другой, на цилиндрическом образце (Ц) ВТСП-керамики. На токовую обмотку подается сигнал от источника тока, а сигнальная обмотка подключается к вольтметру. Исследования проводились на различных образцах, имеющих форму цилиндра диаметром 9 мм и высотой 15 мм. Обмотки выполнены из провода ПЭВ-0,1 по 111 витков каждая, длина каждой 15 мм.

Внешнее магнитное поле — суперпозиция постоянной H_0 и переменной $h_0 \cos(\omega t + \psi)$ составляющих — направлено вдоль оси цилиндрического образца. Постоянная со-



ставляющая H_0 задавалась внешней катушкой (на рис. 1 не указана), в которую вставлялся датчик.

Была исследована зависимость амплитуды отклика ВТСП-образца на внешнее магнитное поле от его параметров H_0 и h_0 . Отклик образца измерялся на частоте (*f*) внешнего гармонического магнитного поля, равной 2 кГц. На рис. 2, *a* представлена зависимость амплитуды сигнала U^* , снимаемого селективным вольтметром с катушки датчика, от внешнего постоянного магнитного поля H_0 при частоте внешнего гармонического воздействия f = 2 кГц: кривая *l* соответствует $h_0 = 2,17$ Э; $2 - h_0 = 11,3$ Э; $3 - h_0 = 18,3$ Э. Образец ВТСП в датчике приводился в сверхпроводящее состояние (замораживался) при $H_0 = 0$, затем значение H_0 увеличивалось до +15 Э, после чего образец приводился в нормальное состояние (размораживался). Далее он снова замораживался при $H_0 = 0$ и значение H_0 снижалось до -15 Э. Характер зависимости $U^*(H_0)$ не изменялся при изменении частоты *f* от 60 Гц до 2 кГц. На рис. 2, *б* представлена зависимость $U^*(h_0)$ при f = 2 кГц и $H_0 = 0$.



Puc. 2

Теоретические исследования. В ходе теоретических исследований предполагалось, что цилиндрический образец из ВТСП-керамики может быть представлен как система сверхпроводящих колец, которые расположены одно под другим, и каждое из колец содержит только один джозефсоновский переход. Данное предположение позволяет использовать выражение [6]

С. В. Черных

$$\frac{\Phi}{\Phi_0} = \frac{\Phi_e}{\Phi_0} + \sum_{n=1}^{\infty} M_n(\beta_e) \sin\left(2\pi n \frac{\Phi_e}{\Phi_0}\right),\tag{1}$$

которое определяет зависимость полного (эффективного) магнитного потока Φ от внешнего потока Φ_e для сверхпроводящего кольца с включенным в него джозефсоновским контактом. Здесь Φ_0 — квант магнитного потока; коэффициенты $M_n(\beta_e)$ определяются через функции Бесселя первого рода $J_n(x)$: $M_n(\beta_e) = (-1)^n J_n(n\beta_e)/(n\pi), 0 \le \beta_e < 1$, $\beta_e = 2\pi L I_1/\Phi_0$, где I_1 — максимальный джозефсоновский ток (т.е. максимальное значение сверхтока), который может протекать по кольцу для поддержания постоянного значения флуксоида, L — индуктивность кольца. Поток через кольцо при этом не квантуется [6].

Пусть

$$\Phi_e = \Phi_d + \Phi_a \sin(\omega t), \qquad (2)$$

где Φ_d — постоянный во времени магнитный поток, Φ_a — амплитуда переменного во времени магнитного потока.

Так как в эксперименте вольтметром измерялась ЭДС в сигнальной обмотке, то можно записать $E = -N(d\Phi/dt)$, где N — число витков в сигнальной обмотке. Поскольку в эксперименте отклик ВТСП-образца измерялся на частоте внешнего гармонического магнитного поля, подставим выражение (2) в формулу (1) и затем, выделив гармоническую составляющую с частотой ω и продифференцировав ее по времени, в результате получим

$$E = -N\frac{d}{dt}\left(\frac{\Phi}{\Phi_0}\right)_{\omega} = -\left[\frac{\Phi_a}{\Phi_0} + \sum_{n=1}^{\infty} M_n(\beta_e)\cos\left(2\pi n\frac{\Phi_d}{\Phi_0}\right)2J_1\left(2\pi n\frac{\Phi_a}{\Phi_0}\right)\right]N\omega\cos(\omega t), \quad (3)$$

откуда

$$E_{\omega} = \left| -\left[\frac{\Phi_a}{\Phi_0} + \sum_{n=1}^{\infty} M_n(\beta_e) \cos\left(2\pi n \frac{\Phi_d}{\Phi_0}\right) 2J_1\left(2\pi n \frac{\Phi_a}{\Phi_0}\right) \right] \right|$$

Результаты теоретических исследований в виде зависимостей $E_{\omega}(\Phi_d/\Phi_0)$ и $E_{\omega}(\Phi_a/\Phi_0)$ показаны на рис. 3, *а* и *б* соответственно, при $\beta_e = 0.85$ и *n*=20.



Puc. 3

ИЗВ. ВУЗОВ. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. 2014. Т. 57, № 1

Обсуждение результатов. Сравнительный анализ рис. 2, *a* и 3, *a* показывает хорошую сходимость зависимостей $U^*(H_0)$ и $E_{\omega}(\Phi_d/\Phi_0)$. Отметим также пропорциональность величин h_0 и Φ_a в этих зависимостях. Действительно,

$$\frac{11,3\,\overline{\Im}}{2,17\,\overline{\Im}} \approx \frac{0,576}{0,111} \approx 5,2 \text{ M} \frac{18,3\,\overline{\Im}}{2,17\,\overline{\Im}} \approx \frac{0,933}{0,111} \approx 8,4$$

Сравнивая рис. 2, б и 3, б, видим, что зависимости $U^*(h_0)$ и $E_{\omega}(\Phi_a/\Phi_0)$ также похожи. Таким образом, свойства гранулированного сверхпроводника можно, в какой-то степени, объяснить свойствами сверхпроводящего кольца с джозефсоновским контактом.

Сформируем модель гранулированного сверхпроводника цилиндрической формы. Будем основываться на представлении керамического образца в виде набора сверхпроводящих гранул, соединенных слабыми связями. Известно, что материал гранул обладает свойствами сверхпроводника второго рода, магнитное поле в который проникает в виде абрикосовских вихрей. Средний размер *l* гранул совпадает с физическими размерами кристаллитов, не превышающими, как правило, 10 мкм [1]. Это позволяет выполнить условие $l >> \lambda$, где λ — лондоновская глубина проникновения поля в гранулы, составляющая при T = 77 К величину порядка 10^{-5} см [1]. Хотя между крупными гранулами имеются пустоты или области, заполненные мелкими кристаллитами размером $l < \lambda$, будем считать число их пренебрежимо малым. Первое критическое поле гранулы H_{c1} составляет 50—100 Э при T = 77 К [1, 7].

Поскольку сверхпроводящие гранулы соединены слабыми связями, магнитное поле $H_{\rm ex} < H_{c1}$ проникает от края цилиндра к его центру по джозефсоновским переходам. На рис. 4 приведено схематическое изображение фрагмента цилиндрического ВТСП-образца (вид сверху) с возможным расположением в нем гранул, которое будем считать более вероятным. Здесь уместно напомнить, что, согласно технологии твердофазного синтеза, в процессе прессования цилиндрического образца гранулы вероятнее всего должны расположиться так, как представлено на рис. 4. Как следует из этого рисунка, глубина проникновения магнитного поля в ВТСП-образец не может быть больше, чем средний размер *l* гранул.



Внутри керамического образца протекает экранирующий (мейсснеровский) ток *j*. Предположим, что ток *j* протекает по сверхпроводящему кольцу шириной *b*, равной среднему размеру *l* гранул, со множеством джозефсоновских переходов $JC_1...JC_n$ (см. рис. 4). Данное кольцо "как бы надето" на сверхпроводник второго рода (выделен на рисунке штриховкой) с $H_{c1} = 50...100$ Э при T = 77 К. Можно предположить, что ток *j* протекает по такому же кольцу, но с одним переходом JC_{Σ} , сопротивление R_{Σ} которого равно сумме сопротивлений переходов $JC_1...JC_n$. Таким образом, цилиндр из ВТСП-керамики будет представлять собой систему из таких сверхпроводящих колец с переходами JC_{Σ} , расположенных одно под другим. В защиту такого представления гранулированного сверхпроводника можно привести следующие данные и расчеты. Сравнение рис. 2, δ и 3, δ показывает, что квант магнитного потока проникает в джозефсоновский переход при внешнем гармоническом магнитном поле $h_0 \approx 18$ Э. Это согласуется с результатами работы [2], где экспериментально измеренное значение нижнего критического джозефсоновского поля H_{c1j} (когда внутрь образца проникает магнитный поток в виде джозефсоновских вихрей) составляет 16 Э. Тогда ширину кольца можно найти по формуле $b = \Phi_0/(h_0 d)$, где $\Phi_0 = 2,07 \cdot 10^{-7}$ Гс·см²; $d = 2\lambda + t = 2,025 \cdot 10^{-5}$ см — толщина области контакта, в которую проникает магнитное поле; $t = 2,5 \cdot 10^{-7}$ см — толщина изоляционной прослойки джозефсоновского перехода. В результате получим $b \approx 5,7 \cdot 10^{-4}$ см, что совпадает с размером *l* сверхпроводящих гранул, указанным в работе [1].

Оценка чувствительности магнитных датчиков. Принцип устройства магнитных датчиков на основе гранулированных сверхпроводников подробно рассмотрен, например, в работах [4, 5]. Главным элементом таких датчиков является цилиндрический сердечник из ВТСП состава YBa₂Cu₃O_{7-x} с обмотками, подключаемый к измерителю слабых магнитных полей (измерительной системе).

Весьма важно оценить уровень шумового потока рассматриваемого датчика в рабочих условиях, так как он определяет минимально обнаружимый внешний поток. Под термином "шум" в данном случае понимается наличие беспорядочных колебаний магнитного потока (шумовой поток).

Для расчетов используем выражение, представляющее собой так называемый классический предел минимально обнаружимого магнитного потока для одноконтактного низкотемпературного (T = 4,2 K) сверхпроводящего квантового интерферометра (СКВИД — Superconducting Quantum Interference Device) [6]:

$$(\delta\Phi)_{\text{class}} = \left\langle \delta\Phi_N^2 \right\rangle^{1/2} = L \left(\frac{4k_B T \,\delta\nu}{R}\right)^{1/2},\tag{4}$$

где $\langle \delta \Phi_N^2 \rangle$ — среднеквадратическое значение шумового потока; *R* — нормальное сопротивление слабой связи; $\delta v = \delta \omega / (2\pi)$ — полоса частот; k_B — постоянная Больцмана.

Для типичных значений $L = 10^{-10}$ Гн, R = 5 Ом и T = 4 К чувствительность СКВИДа к потоку составляет $3, 2 \cdot 10^{-7} \Phi_0 / \sqrt{\Gamma \mu}$ [6]. Типичные значения L получены для диаметра сверхпроводящего кольца 1—2 мм, а типичные значения R — для площади туннельных контактов 1—100 мкм² [6].

Оценим с помощью выражения (4) чувствительность к магнитному потоку датчика с цилиндрическим сердечником диаметром 2 мм. В рассматриваемом случае значение R_{Σ} будет значительно больше. Нормальное сопротивление межзеренного контакта в массивных образцах (согласно работе [8]) составляет 0,1—10 Ом. Примем для расчетов его значение равным 10 Ом; проведя вычисления, получим $R_{\Sigma} \approx 11$ кОм, T = 77 К. Рассмотренные сверхпроводящие кольца обладают малой индуктивностью, поскольку магнитное поле сосредоточено в межзеренных контактах. Учитывая размеры зерен, лондоновскую глубину проникновения и толщину диэлектрического слоя между зернами, можно найти значение индуктивности L, которое для кольца диаметром 2 мм составит $1,8 \cdot 10^{-12}$ Гн. В результате получим значение $5,5 \cdot 10^{-10} \Phi_0 / \sqrt{\Gamma_{II}}$ для контакта JC_Σ.

Поскольку кольца с контактами JC_{Σ} расположены одно под другим, то их шумовые потоки будут складываться. Понятно, что чем длиннее сердечник датчика, тем хуже его чувст-

вительность. Без ущерба для технических характеристик можно создать датчик длиной 5 мм. Чувствительность к потоку такого датчика составит $4,8\cdot10^{-7} \Phi_0 / \sqrt{\Gamma \mu}$, а чувствительность к магнитному полю достигнет величины $7,9\cdot10^{-9} \exists / \sqrt{\Gamma \mu}$.

Заключение. В результате экспериментальных и теоретических исследований можно утверждать следующее:

— глубина проникновения внешнего гармонического магнитного поля в сверхпроводящий образец при $h_0 \approx 0...18$ Э не превышает размеров сверхпроводящих гранул;

— джозефсоновские вихри начинают проникать внутрь слабых связей сверхпроводящего образца при $h_0 \ge 18$ Э;

— чувствительность к потоку датчиков на основе ВТСП-керамики может достигать чувствительности СКВИДов при T = 77, а не при T = 4 К (для СКВИДа).

Заметим также, что датчики магнитного поля, разработанные на основе ВТСП состава YBa₂Cu₃O_{7-x}, отличаются простотой конструкции по сравнению со СКВИДами (на основе как обычных сверхпроводников, так и пленок высокотемпературных сверхпроводников), а также более надежны и долговечны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Дзугутов В. М., Подлевских Н. А., Фишер Л. М. Проникновение низкочастотного магнитного поля в ВТСПкерамику // Сверхпроводимость: физика, химия, техника. 1990. Т. 3, № 1. С. 47—56.
- 2. Коноплева Р. Ф., Чащин В. С. Исследование методом высокочастотного поглощения параметров ВТСПматериалов, облученных быстрыми нейтронами реактора // Физика твердого тела. 1997. Т. 39, № 1. С. 28—34.
- 3. Белодедов М. В., Черных С. В. О проникновении магнитного поля в гранулированный сверхпроводник // ЖТФ. 2003. Т. 73, вып. 2. С. 75—79.
- 4. Белодедов М. В., Черных С. В. Высокочувствительные магнитометры на основе ВТСП-керамики // ПТЭ. 2001. № 4. С. 157—161.
- Головашкин А. И., Кузьмичев Н. Д., Славкин В. В. Простое чувствительное устройство для измерения слабых магнитных полей на основе высокотемпературного сверхпроводящего иттриевого купрата // ЖТФ. 2006. Т. 76, вып. 3. С. 81—85.
- 6. Бароне А., Патерно Дж. Эффект Джозефсона: физика и применения: Пер. с англ. М.: Мир, 1984.
- 7. Физические свойства высокотемпературных сверхпроводников / Пер. с англ.; Под ред. Д. М. Гинзберга. М.: Мир, 1990.
- 8. *Куприянов М. Ю., Лихарев К. К.* Эффект Джозефсона в высокотемпературных сверхпроводниках и структурах на их основе // Успехи физ. наук. 1990. Т. 160, вып. 5. С. 49—87.

Сведения об авторе

Сергей Викторович Черных — канд. физ.-мат. наук, доцент; Волгоградский государственный университет, кафедра телекоммуникационных систем; E-mail: schtks@list.ru

Рекомендована кафедрой телекоммуникационных систем

Поступила в редакцию 04.11.13 г.